



## VGF InP n型・p型 基板 標準仕様

ドーパント、導電型	S・Snドーブ (n型)	Unドーブ (n型)	Znドーブ (p型)
サイズ	2インチ 3インチ 4インチ		
面方位	(100)±0.5°		
	(311)A, B±0.5° (111)A, B±0.5° ※オフ角の大きな面方位はn型Sドーブのみ生産		

キャリア濃度	(cm <sup>-3</sup> )	(0.8~8.0)×10 <sup>18</sup>	(1.0~10.0)×10 <sup>15</sup>	(0.5~5.0)×10 <sup>18</sup>
抵抗率	(Ω.cm)	N/A	N/A	N/A
モビリティ	(cm <sup>2</sup> /V.S)	(1.0~2.5)×10 <sup>3</sup>	(3.0~5.0)×10 <sup>3</sup>	50~100
EPD (Ave)	(cm <sup>2</sup> )	100~5,000	≦5,000	≦5,000

直径	(mm)	50.8±0.3	76.2±0.3	100±0.3	—
厚さ	(μm)	350±25	625±25	625±25	—
TTV (両面研磨)	(μm)	≦4	≦4	≦4	—
TTV (片面研磨)	(μm)	≦10	≦10	≦10	—
Warp	(μm)	≦10	≦10	≦10	—
OF長さ	(mm)	17.0±1.0	22.0±1.0	32.5±1.0	—
IF長さ	(mm)	7.0±1.0	12.0±1.0	18.0±1.0	—

レーザーマーク	オプション				
面仕上げ	表面	鏡面研磨 (エピレディ)			
	裏面	エッチド/鏡面研磨			
梱包形態	個別トレイ/カセット				



## VGF InP 半絶縁型 基板 標準仕様

ドーパント、導電型	Feドーブ (半絶縁型)				
サイズ	2インチ 3インチ 4インチ				
面方位	(100)±0.5°				
	(311)A, B±0.5° (111)A, B±0.5°				

キャリア濃度	(cm <sup>-3</sup> )	N/A			
抵抗率	(Ω.cm)	≧1.0×10 <sup>7</sup>			
モビリティ	(cm <sup>2</sup> /V.S)	≧1,000			
EPD (Ave)	(cm <sup>2</sup> )	1,500~5,000			

直径	(mm)	50.8±0.3	76.2±0.3	100±0.3	—
厚さ	(μm)	350±25	625±25	625±25	—
TTV (両面研磨)	(μm)	≦10	≦10	≦10	—
TTV (片面研磨)	(μm)	≦10	≦15	≦15	—
Warp	(μm)	≦15	≦15	≦15	—
OF長さ	(mm)	17.0±1.0	22.0±1.0	32.5±1.0	—
IF長さ	(mm)	7.0±1.0	12.0±1.0	18.0±1.0	—

レーザーマーク	オプション				
面仕上げ	表面	鏡面研磨 (エピレディ)			
	裏面	エッチド/鏡面研磨			
梱包形態	個別トレイ/カセット				

※各種ウエハーの仕様はご相談に応じます。